

(公財) 科学技術交流財団
第1回「ポストグラフェン材料のデバイス開発研究会」開催案内

日時 平成30年6月11日 (月) 13:30～18:00

場所 科学技術交流財団研究交流センター (ウイंकあいち 15F)

財団挨拶 (13:30～13:40)

座長挨拶 (13:40～13:50)

名古屋大学大学院 工学研究科エネルギー理工学専攻 准教授 柚原 淳司

特別講演 (13:50～14:50)

「半導体表面で生成する原子層新物質」

京都大学大学院 理学研究科化学専攻 教授 有賀 哲也 氏

メンバー紹介 (14:50～15:05)

休憩 (15:05～15:20)

招待講演 (15:20～16:10)

「ヘテログラフェンの合成と構造」

名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 斉藤 永宏 氏

招待講演 (16:10～17:00)

「Si-Ge 系スーパーアトム構造の高密度集積と光・電子物性制御」

名古屋大学大学院 工学研究科電子工学専攻 教授 宮崎 誠一 氏

交流会 (17:00～18:00)